脊背型介质加载表面等离子体波导传输特性研究

郑洪全1,宁海春2

(1. 哈尔滨理工大学 测控技术与通信工程学院,黑龙江 哈尔滨 150080;2. 大连民族大学 信息与通信工程学院,辽宁 大连 116600)

摘 要:为降低传输过程中的损耗,加强介质加载等离子体波导的模式场约束,并且优化等离子体波 导的传输性能,对基于介质加载的表面等离子体波导的传输特性做了进一步的研究,设计了一种脊背 型介质加载等离子体波导,并对其模式场分布及其传输参数随波导中的几何参数与电磁参数的变化 关系做了相应的研究。仿真结果得出:基模的电场分量主要分布在该结构的金属/介质层1界面。该模 式的传输特性,随着该波导的几何参数的变化而发生相应改变,因而可以通过改变这种结构的几何参 数,对场实现有效控制,使其局域性明显增强。

关键词:等离子波导; 传输特性; 局域性 中图分类号:O531 文献标志码:A DOI: 10.3788/IRLA201645.1020005

Research on waveguide transmission characteristics of spine type medium load surface plasmon

Zheng Hongquan¹, Ning Haichun²

 School of Measurement and Control Technology and Communication Engineering, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150080, China;

2. School of Information and Communication Engineering, Dalian Nationalities University, Dalian 116600, China)

Abstract: In order to reduce the transmission loss, strengthen the medium loaded plasma waveguide mode field constraint and optimize the plasma waveguide transmission performance, a further research on waveguide transmission characteristics of the dielectric loaded surface plasmon was studied. A waveguide with spine type medium load plasma was designed and the relationship between the geometric parameters and the geometrical parameters of the waveguide in the mode field distribution and its transmission parameters were studied. The simulation results show that the electric field component of the base mode is mainly distributed in the metal/dielectric layer 1 interface. As a result, the transmission characteristic of the model changes with the variations of the geometrical parameters of waveguide. Hence, the field can be effectively controlled by shifting the geometrical parameters of the waveguide and localization can be enhanced obviously.

Key words: plasma waveguide; transmission characteristics; locality

收稿日期:2016-02-11; 修订日期:2016-03-20

作者简介:郑洪全(1990-),男,硕士生,主要从事非线性光学方面的研究。Email:zhenghongquan0257@126.com 导师简介:于晓洋(1962-),男,教授,主要从事数字图像处理方面的研究。

0 引 言

在微纳米光电子集成领域,实现纳米尺度的光 波导成为研究的趋势。在各种纳米光子波导中,表面 等离子体(SPPs)波导引起了学者的广泛关注。基于 表面等离子体的光子器件能够突破传统光子器件存 在的衍射极限的限制,为进一步将光子和电子的优 势结合在一起并在芯片上集成应用提供了可能^[1-2]。 等离子体波导及其相关器件在微纳米光电子集成领 域拥有巨大的潜力^[3-4],近些年,出现了几种等离子 体波导结构,如:金属条与金属纳米圆柱波导^[5-6],耦 合纳米圆柱波导^[7-8],金属-V型波导^[9],金属-介质-金属波导等。然而,这些波导结构中所存在的传播损 耗,场限制和物理尺寸等问题影响了波导的传输性能。

为了实现较长的传播距离并提高波导的模式限 制,近些年来,混合表面等离子体波导的研究获得了 越来越多的关注[10-11]。这些混合等离子体波导对深 亚波长尺度的光集成有很大的影响,尤其是介质加 载混合等离子波导,这是因为该波导存在介质折射 率差,它使得金属/质界面的 SPPs 波局域化加强,使 其具有亚波长场限制下的低损耗[12-13]。2007年曾有 报道 Holmgaard 等人验证了介质加载等离子体波导 具有很好的横向模式场限制和侧向模式场限制,并 且具有较长的传播距离[14]。2009年东南大学则指出 在金属条的另一边同样放置一个高折射率介质层形 成对称的介质加载等离子波导可以显著提高波导的 传输性能,但是模式尺寸相对较大^[15]。2010年 Chu 等人提出了一种双层介质加载混合等离子波导,结 果表明,这种波导结构可以实现强烈的场限制以及 相对较长的传播距离,但是仍然存在着很严重的传 输损耗问题[16]。

为了降低传输过程中的损耗,同时加强介质加 载等离子体波导的模式场的约束,进一步优化等离 子体波导的传输性能,文中对这种基于介质加载的 表面等离子体波导的传输特性做了进一步的研究。 文中设计了一种脊背型介质加载等离子体波导,并 对其模式场分布,及其传输参数随波导中的几何参 数与电磁参数的变化关系做了相应的研究。

1 介质加载型表面等离子体波导结构

1.1 理论分析

图1为介质加载型表面等离子体波导结构示意

图。建立该等离子体波导在 TM 模式下的电磁场物 理模型^[14]:设 H_{xi}, E_{yi}, E_i分别为该结构中第 *i* 层的电 场和磁场,由于 SPPs 为 TM 偏振波,则应满足下式:



图 1 y-z 平面上的介质加载型表面等离子体波导结构

Fig.1 Surface plasmon waveguide structure of y-z type medium loaded on the plane

$$\frac{d^2 H_{xi}(y)}{dy^2} + k_{yi}^2 H_{xi}(y) = 0 \tag{1}$$

$$E_{zi}(y) = -\frac{j}{\omega\varepsilon_{i}} \frac{\mathrm{d}H_{xi}(y)}{\mathrm{d}y} \tag{2}$$

$$E_{yi}(y) = \frac{k_{yi}}{\omega \varepsilon_i} H_{xi}(y)$$
(3)

其中,横向波矢 $k_{,i}$ 与纵向波矢 β 满足:

$$k_{yi} = \pm \sqrt{k_0^2 \varepsilon_i - \beta^2} , i = 1, 2, 3$$

$$\tag{4}$$

根据切向场连续的边界条件,上边界切向场 (*H_x*,*E_x*)和下边界切向场(*H_x*,*E_x*)可通过传输矩阵 *M_i* 联系起来:

$$\begin{bmatrix} H_{xs} \\ \frac{dH_{xs}}{\varepsilon_{s} dy} \end{bmatrix} = \prod_{i=1}^{3} M_{i} \begin{bmatrix} H_{xc} \\ \frac{dH_{sc}}{dy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_{xc} \\ \frac{dH_{sc}}{\varepsilon_{c} dy} \end{bmatrix}$$
(5)

$$M_{i} = \begin{bmatrix} \cos(k_{yi}h_{i}) & -\frac{\mathcal{E}_{i}}{k_{yi}}\sin(k_{yi}h_{i}) \\ \frac{k_{yi}}{\mathcal{E}_{i}}(k_{yi}h_{i}) & \cos(k_{yi}h_{i}) \end{bmatrix}$$
(6)

进而可以得到色散方程:

$$F(\beta) = \frac{k_{vs}}{\varepsilon_s} m_{11} + \frac{k_{vc}}{\varepsilon_c} m_{22} - m_{21} - \frac{k_{vs}k_{vc}}{\varepsilon_s\varepsilon_c} m_{22} = 0$$
(7)

式中: $k_{yx}=\pm\sqrt{\beta^2-k_0^2\varepsilon_c}$, $k_{ys}=\pm\sqrt{\beta^2-k_0^2\varepsilon_s}$ 。 1.2 波导材料的选择

目前不断有新型材料被研发生产,其中用于集成光学的材料种类众多,包括SiO₂,Si,LiNbO₃,GaAs,InP以及有机高分子材料等,这些材料都具有其独特之处,这就成就了集成电子器件的多样化。

在选择光波导材料时,主要考虑该材料的损耗

问题,优先选择损耗较低的材料。通常要求光波导的 传输损耗小于1dB/cm。在工艺方面,还要具备便于 成膜,刻蚀等制作等特点。综合考虑,文中所选择的 介质材料为SiO₂和Si。SiO₂材料是最早被广泛应用 的光波导材料之一。该材料折射率用如下公式表示:

$$n = \sqrt{1 + \sum_{j=1}^{3} \frac{\lambda^2 B_j}{\lambda^2 - \lambda_j^2}}$$
(8)

式中: B_1 =0.696 163 3, B_2 =0.407 942 6, B_3 =0.897 499 4, λ_1^2 =0.004 679 148 μ m², λ_2^2 =0.013 512 068 μ m², λ_3^2 = 97.934 002 μ m²。在光通信波长为 1 550 nm 时,其折 射率约为 1.445。同样 Si 材料也是一种广泛应用集 成电路的材料。Si 优越的性能以及与 CMOS 集成电 路工艺的兼容,将降低光子集成器件的成本。基于 此,其得到了广泛的研究和应用。下式为硅折射率与 波长的关系:

 $n_{si}=n_{0}+\frac{A_{1}}{\lambda^{2}-\Lambda_{1}}+\frac{A_{2}}{(\lambda^{2}-\Lambda_{1})^{2}}+A_{3}\lambda^{2}+A_{3}\lambda^{2}+(T-T_{0})\frac{d_{n}}{dT}$ (9) 式中: $n_{0}=3.416$ 96, $A_{1}=0.138$ 496, $A_{2}=0.013$ 924, $A_{3}=-2.09\times10^{-5}, A_{4}=1.48\times10^{-7}, \Lambda_{1}=0.028, T_{0}=293$ K, dn/ dT=1.5×10⁻⁴K⁻¹。在光通信波长为1550 nm时,其折 射率为3.45。

表面等离子体波导的金属材料为色散介质,其 介电常数并不是固定值。当光频率改变时,介电常数 随之发生变化。因此进行表面波导的研究过程中,选 择适当的色散模型是十分必要的。针对微纳米光学 结构,一般选用 Lorentz-Drude 模型。其表达式为:

$$\varepsilon_r = \varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - i\omega\gamma}$$
(10)

此次所设计的波导选用的金属材料为银,则当入 射波长为1550 nm时,其介电常数为: *ε*_{Ag}=-126+2.9*i*。

1.3 COMSOL Multiphysics 参数设置

文中选用的 COMSOL Multiphysics 多物理场仿 真软件,是基于有限元算法而研发生产的一款多功 能软件。使用 COMSOL 软件进行基本参数设置时, 根据需要首先建立模型,文中所设计的波导结构为 二维结构,因而,在空间维度节点中选取二维结构; 在物理场的选择节点中,选取电磁波;在电磁波模块 的求解类型中选取模态分析功能。

模型设计的参数选择:此次设计的模型为三层 波导结构。在仿真过程中,利用三个矩形结构来代替 三层波导中的三层结构模型。矩形的水平长度代表 波导的传播长度,矩形的垂直宽度表示波导的厚度。 其中文中设计的波导结构的银的厚度为 100 nm,介 质 1 的厚度为 50 nm,介质 2 的厚度为 150 nm。

材料节点的参数选择:主要是对 Ag 和空气设置 介电常数。银的介电常数 ε_{Ag}=-126+2.9*i* 在求解节点 中,设置波导的入射光波长,在此例中入射光波波长 为 λ=1 550 nm。该软件在求解的过程中,会将解出的 每个模式转换成其在波导结构中的有效折射率。 建模节点完成以后,对波导模型进行计算仿真, COMSOL 软件的仿真结果以图形或者图表的形式 显示出来,利用色彩的变化表现场的分布。

1.4 场分布

当介质为不同组合时,其基模的归一化电场分 布如图 2 所示。通过图 2,可以观察到传统介质加载 型表面等离子体波导结构中,介质为不同组合时,基 模的电场强度的分布情况。其中 2(a)和 2(b)分别显 示的是介质 1 和介质 2 均为 SiO₂和 Si 时的电场的 分布图。从这两幅图中可以看出,当介质 1 与介质 2 为同一种材料时,电场的集中程度差,表面等离子波 的局域性较差。图 2(c)描述的是介质 1 为 Si,介质 2 为 SiO₂条件下的基模电场的分布状态图,可以看出 光波大部分能量分布在介质 2 区域,介质 1 区域分 布较少。图 2(d)描述的是介质 1 为 SiO₂,介质 2 为 Si 情况下的电场分布图。此种情况下的表面等离子波 局域性较好,但并不理想,进而对该结构进行改进。 将对改进的结构-脊柱混合介质表面等离子体波导 进行进一步分析。



图 2 介质组合不同时的电场分布情况

Fig.2 Electric field distribution when the medium has different combination

2 脊背型介质加载表面等离子体波导模型 设计

如图 3 所示为脊背型介质加载型表面等离子结构,介质 1(SiO₂)和介质 2(Si)的高度分别为 d 和 t,介





质 2 的宽度为 w,其中介质 1 的折射率表示为 n₁,介 质 2 的折射率表示为 n₂。将理论模型应用于该结构,即可得到该结构的色散方程为:

$$\tan\left(k_{H}t - \tan^{-1}\left(\frac{\varepsilon_{c}k_{H}}{\varepsilon_{H}\gamma_{c}}\right)\right) = \frac{\varepsilon_{H}\gamma_{L}}{\varepsilon_{L}\gamma_{H}} \cdot \left(\frac{\varepsilon_{M}\gamma_{L} + \varepsilon_{L}\gamma_{M} - (\varepsilon_{M}\gamma_{L} + \varepsilon_{L}\gamma_{M})e^{(-2\gamma_{L}d)}}{\varepsilon_{M}\gamma_{I} + \varepsilon_{I}\gamma_{M} + (\varepsilon_{M}\gamma_{I} + \varepsilon_{I}\gamma_{M})e^{(-2\gamma_{L}d)}}\right)$$
(11)

式中:传播常数为 $\beta = \beta_r + j\beta_i$ 。其可以表示为:

 $β^2 = β_r + j β_i = ε_H k_0^2 - k_H^2 = ε_L k_0^2 + \gamma_L^2 = ε_C k_0^2 + \gamma_C^2 = ε_M k_0^2 + \gamma_M^2$ (12) 式中: ε_L 和 ε_H 分别为介质 1 和介质 2 的介电常数; ε_M 为金属的介电常数; γ_L, γ_M, γ_C 为金属中的衰减系 数。所选用的 COMSOL 软件可以在求解波导结构的 过程中,直接算得该结构的传播常数,从而得到该模 式下有效折射率 N_{eff}= β/k₀ 和传播长度 L_{prop}=1/2β_i。

3 脊背型介质加载表面等离子体波导传输 特性分析

文中的重点内容为讨论波导的几何参数,对于 电磁场能量分布的影响,从而有针对性地调整波导 结构,有效提高波导的传输距离,降低损耗。有效折 射率和传播距离常常被用来衡量波导传输性能。针 对文中所设计的波导结构,选择 λ=1 550 nm 的入射 波,分析波导几何参数对于基模的电场分布的影响, 以及有效折射率和传播距离同波导几何参数所存在 的变化关系。

3.1 介质1厚度 d 对传输特性的影响

当 t=150 nm,w=200 nm,介质1厚度 d 分别取 10、30、50 nm 时,电场基模的分布图如图 4 所示,从 图中可以发现,基模的电场主要分布于脊背介质加 载型波导的介质1区域。通过观察这三幅图可以发 现,当 t 和 w 固定,脊背介质加载型波导的介质1厚 度 d 较小时,电场的局域性增强,能量主要分布于介 质1中,而分布于介质2中的能量明显减少。

针对图 4,为了更清楚地理解这一现象,分析了 同有效折射率和传播长度之间的关系,图 5 即为有 效折射率和传播长度随介质 1 厚度 d 的变化关系曲 线图。





图 4 d 为不同值时的电场分布情况 Fig.4 Electric field distribution when d is different

观察图 5 可知,当 d 增大时,有效折射率减小, 但传播距离变化趋势与之相反,其随着 d 的增大而 增大。这是因为通过减小 d,金属与介质的耦合程度 增强,能量主要分布在金属/介质 1 界面上,使得场 的局域性增强;当 d 增大时,金属与介质 1 的耦合程 度降低,这使得场的能量分布较分散,场的局域性减 弱,有一部分能量分布在介质 2 中,从而损耗降低, 传播距离增加。







(b) 传播长度随介质 1 厚度 d 的变化关系曲线图

- (b) Relationship graph of the propagation length change with the thickness d of medium 1
 - 图 5 介质 1 厚度 d 为不同值时波导的传输特性曲线
 - Fig.5 Transfer characteristic curve of waveguide when the thickness d of medium 1 is different

3.2 介质 2 的几何参数对传输特性的影响

其他仿真条件不变,对介质2的厚度 *t* 对波导传 输特性的影响进行分析。当 *d*=30 nm,*t* 分别取 100、 150、200 nm 时,电场分布情况如图 6 所示。



图 6 介质 2 厚度 t 为不同值时的电场分布情况 Fig.6 Electric field distribution when the thickness t of medium 2 is different

对比图 6和图 4 可以发现,两组图电场分布情况相类似,但其强度有所改变。基模的电场分量主要分布于脊背介质加载型波导的介质 1 区域。对有效折射率和传播长度同 w 的变化关系进行分析,结果如图 7 所示。

观察图 7 可以发现,有效折射率随 w 的增大而 增大,传播距离的变化趋势同之相反,传播距离随 w 的增大而减小。同时可以发现当 w 一定时,有效折射 率随着 t 增加而增加,如图 7(a)所示,传播距离随着 t 增加而减小,如图 7(b)所示。这是因为随着介质 2 的厚度 t 的增加,高折射率介质限制了场的能力加 强,从而使得金属与介质的耦合作用加强,能量分布 相对集中。



(a) 有效折射率随介质 2 宽度 w 的变化关系曲线图

(a) Relationship graph of the effective refractive index change with the width *w* of medium 2



(b) 传播长度随介质 2 宽度 w 的变化关系曲线图

(b) Relationship graph of the propagation length change with the width *w* of medium 2

图 7 介质 2 宽度 w 不同时波导的传输特性曲线

Fig.7 Transfer characteristic curve of waveguide when the width *w* of medium 2 is different

4 结 论

文中设计了一种脊背型介质加载型表面等离子 体波导结构,这种波导的结构由介质1的厚度 d、介 质 2 的厚度 t 和宽度 w,三个几何参数共同作用。选 用 COMSOL 软件进行模拟分析该结构的几何参数 对传输特性的影响。从仿真结果可以看出:基模的电 场分量主要分布该结构的金属/介质层1界面。改变 介质 1 和介质 2 组合,其电场分布也随之发生变 化,当介质 1 为低折射率介质,介质 2 为高折射率 介质时,其电场大部分能量集中于金属/介质 1 界 面,表明其局域性增强;通过增加介质 1 和介质 2 的厚度,传播长度分别呈现增加和减小的变化趋势, 因而可以通过调节结构的几何参数,达到改变耦合 电磁场能量的目的。通过对比分析可知:文中设计的 脊背型介质加载型表面等离子体波导结构相比于传统的介质加载型表面等离子体波导结构,具有更高的性能,能够对场实现更加有效的控制,使其局域性更强。文中设计的结构不仅拓宽了介质加载型表面等离子体波导结构的理论基础,并且在纳米光学的集成光学器件的研究中具有一定的应用潜能。

参考文献:

- Ozbay E. Plasmonics: Merging photonics and electronics at nanoscale dimensions[J]. *Science*, 2006, 311(5758): 189–193.
- [2] Dong P, Liu X, Chandrasekhar S, et al. Monolithic silicon photonic integrated circuits for compact 100 Gb/s coherent optical receivers and transmitters[J]. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, 2014, 20(4): 150–157.
- [3] Almedia V R, Xu Q, Barrios C A, et al. Guiding and confining light in void nanostructure[J]. *Optics Letter*, 2004, 29(11): 1209–1211.
- [4] Zia R, Schuller J A, Chandran A, et al. The next chip-scale technology[J]. *Materials Today*, 2006, 9(7): 20–27.
- [5] Paul A, Zhen Y R, Wang Y, et al. Dye-assisted gain of strongly confined surface plasmon polaritons in silver nanowires[J]. *Nano Letters*, 2014, 14(6): 3628–3633.
- [6] Lal S, Hafner J H, Halas N J, et al. Noble metal nanowires: from plasmon waveguides to passive and active devices [J]. *Accounts of Chemical Research*, 2012, 45(11): 1887–1895.
- [7] Chu H S, Ewe W B, Koh W S, et al. Remarkable influence of the number of nanowires on plasmonic behaviors of the coupled metallic nanowire chin [J]. *Applied Physics Letter*, 2008, 92(10): 3103–3104.
- [8] Xu W, Zhu Z H, Liu K, et al. Dielectric loaded graphene

plasmon waveguide[J]. *Optics Express*, 2014, 23(4): 5147-5153.

- [9] Pile D F P, Ogawa T, Gramotnev D K, et al. Twodimensionally localized modes of a nanoscale gap plasmon waveguide[J]. *Applied Physics Letter*, 2005, 87(26): 1114– 1117.
- [10] Guan X, Wu H, Shi Y, et al. Ultracompact and broadband polarization beam splitter utilizing the evanescent coupling between a hybrid plasmonic waveguide and a silicon nanowire[J]. *Optics Letters*, 2014, 38(16): 3005–3008.
- [11] Gao L, Tang L, Hu F, et al. Active metal strip hybrid plasmonic waveguide with low critical material gain [J]. *Optics Express*, 2012, 20(10): 11487–11495.
- [12] Kamalakis T, Alexandropoulos D, Vainos N. Efficient design of polymer micro-ring resonator filters based on coupled mode theory and finite difference mode solver [J]. *Optics Communications*, 2014, 339(27): 123–128.
- [13] Holmgaard T, Bozhevolnyi S I. Theoretical analysis of dielectric-loaded surface plasmon-polariton waveguides [J].
 Physical Review B, 2007, 75(24): 245405.
- [14] Yun Binfeng, Hu Guohua, Cui Yiping. Bound modes analysis of symmetric dielectric loaded surface plasmon-polariton waveguides[J]. *Optics Express*, 2009, 17(5): 3610–3618.
- [15] Flammer P D, Banks J M, Furtak T E, et al. Hybrid plasmon/dielectric waveguide for integrated silicon-oninsulator optical elements [J]. *Optics Express*, 2010, 18(20): 21013–21023.
- [16] Chu H S, Li E P, Bai P, et al. Optical performance of single-mode hybrid dielectric-loaded plasmonic waveguidebased components [J]. *Applied Physicals Letters*, 2010, 96 (22): 221103.